

V0.8 2201

### 性能特点

● 工作频段: 23.5GHz~26.8GHz

● 低功耗: 148mA● 输出功率: 5dBm

● 相位噪声: -102dBc/Hz@100kHz

■ 封装尺寸: 24引脚QFN, 4mmx4mm

#### 典型应用

- 点对点通信
- 卫星通信
- 测试测量
- 仪器仪表

#### 5G通信

#### 24 23 22 21 20 19 1 18 GND RF/8 2 17 GND 3 16 RFOUT VCCD 4 15 GND 14 GND 5 NC 6 13 NC NC. 9 10 11 12 8 NC NC NC NC

功能框图

#### 概述

SIV009SP4型压控振荡器具有同频率范围极低的相位噪声,极低的1/2、3/2及N次谐波干扰,低功耗,平坦的输出功率的特点。

SIV009SP4型压控振荡器采用24引脚4mmx4mm表贴无引线塑料封装。引脚焊盘镀层为Sn。

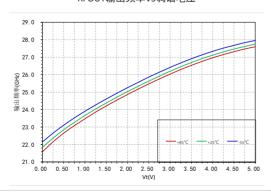
#### 电性能表(TA=+25℃, VCC=VCCD=5V)

参数名称	端口名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	RFOUT		23.5~26.8		GHz
±∆	RFOUT	1	5	9	dBm
输出功率	RF/8	-4	-2	0	dBm
单边带相位噪声@100kHz频 偏,Vt=+2V	RFOUT		-102		dBc/Hz
调谐电压	Vt	0		5	٧
偏置电压	VCC, VCCD		5		٧
偏置电流	Vcc (RF)	115	128	135	- mA
	Vcc (DIG)	18	20	22	
调谐电流(Vt=+5V)	Vt			1	uA
NH: Neb 400 A-ul	1/2次谐波		30		dBc
谐波抑制	3/2次谐波		40		dBc
推频系数			40		MHz/V
频率温飘			2. 55		MHz/°C

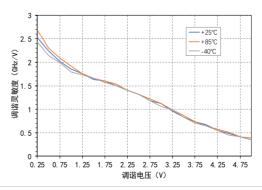
注:芯片应用时需先加VCC,再加Vt

#### 测试曲线

#### RFOUT输出频率VS调谐电压



#### RFOUT调谐灵敏度VS调谐电压



成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

测试曲线

# SIV

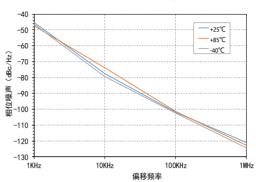
压控振荡器系列

RFOUT输出功率VS调谐电压

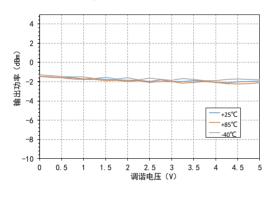
8
7
(eB) 5
(H) 7
(

V0.8 2201

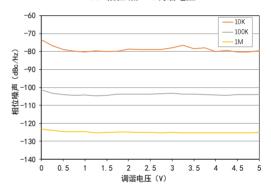
RFOUT相位噪声VS偏移频率@Vt=+2V



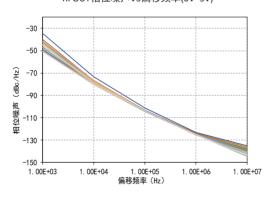
RF/8输出功率VS调谐电压



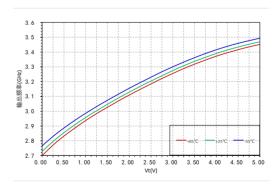
RFOUT相位噪声VS调谐电压



RFOUT相位噪声VS偏移频率(0V~5V)



RF/8输出频率VS调谐电压



成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

压控振荡器系列

## 极限工作参数

偏置电压	5. 5V
调谐电压	0V∼5. 5V
存储温度范围	-65°C∼+150°C
工作温度范围	-40°C∼+85°C
静电防护等级(HBM)	Class 1B

V0.8 2201

### 封装信息

型号	封装材料	焊盘镀层	MSL等级[1]	封装标识[2]	环保要求
S1V009SP4	绿色树脂化合物	Sn	MSL 3	S009 XXXXX	符合RoHS

[1] 最高回流焊温度260℃

[2] XXXXX为批号

### 引脚定义

引脚编号	功能符号	功能描述	引脚编号	功能符号	功能描述
1	NC	空置	13	NC	空置
2	RF/8	射频输出	14	GND	射频地
3	NC	空置	15	GND	射频地
4	VCCD	直流偏置	16	RFOUT	射频输出
5	NC	空置	17	GND	射频地
6	NC	空置	18	GND	射频地
7	NC	空置	19	NC	空置
8	NC	空置	20	VCC	直流偏置
9	NC	空置	21	NC	空置
10	NC	空置	22	VT	调谐电压
11	NC	空置	23	NC	空置
12	NC	空置	24	NC	空置

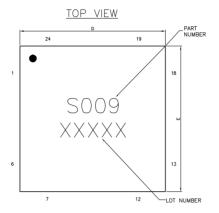
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

外形尺寸

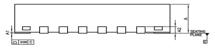
# SIV

压控振荡器系列



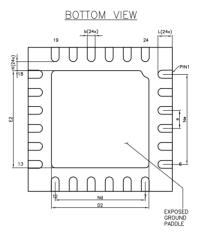
V0.8 2201





#### 说明:

- 1. 单位: mm
- 2. 引线框架材料:铜合金
- 3. 引线间隔公差非累积
- 4. 管壳表面翘曲: 不大于 0.05mm
- 5. 所有接地引脚请连接PCB射频地



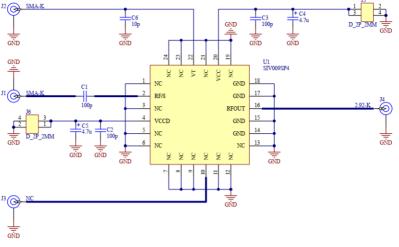
Dime	Dimension Table (unit:mm)			
Symbol	MIN	NOM	MAX	
Α	0.80	0.90	1.00	
A1	0.00	0.02	0.05	
A2	0.203Ref			
b	0.18	0.25	0.30	
D	3.95	4.00	4.05	
D2	2.55	2.70	2.80	
е	0.50BSC			
Ne	2.50BSC			
Nd	2.50BSC			
E	3.95	4.00	4.05	
E2	2.55	2.70	2.80	
К	0.15			
L	0.30	0.40	0.50	
aaa	0.08			

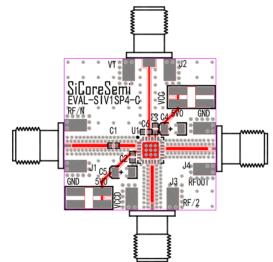
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

V0.8 2201

评估板





Designator	Description
C1, C2, C3	多层陶瓷电容 0402 100pF
C4, C5	钽电容 1206 4.7uF
C6	多层陶瓷电容 0402 10pF
J1, J2	SMA-K PCB 连接器
J4	2.92-K PCB 连接器
J5, J6	2. Omm DC 引脚
U1	S1V009SP4

J1, J2 推荐使用南京傲文D550B12E01-023型SMA-K 连接器 J4 推荐使用南京傲文D360B12E01-023型2.92-K 连接器

电路板材:Rogers4350B

器件应用的电路板应按照射频电路的设计方法设计, 信号 线按50 ohm阻抗设计, 同时封装壳体的接地引脚就近接地 (与图中类似), 连接顶层与底层接地面应有足够多的接地 孔。

向仕芯半导体申请可获得评估板。

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼